

فرونشانی ابررسانایی با آلایش $\text{RBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ در Pr_{CuO_2} : مفاهیم جایگزیدگی و انبوهه سازی حفرهای در صفحات

وحید دادمهر^{۱*}، محمد دهقان نیری^۲ و علی رضاخانی طایفه^۲

۱. آزمایشگاه پژوهشی مغناطیس و ابررسانا، گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا (س)، کد پستی ۱۹۹۳۸۹۱۷۶، تهران - ایران

۲. دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی ۱۶۸۴۴، تهران - ایران

پست الکترونیکی: daadmehr@alzahra.ac.ir

(دریافت مقاله: ۸۵/۳/۶؛ دریافت نسخه نهایی: ۸۵/۸/۱)

چکیده

آلایدگی سیستم Pr_{CuO_2} با سبب ایجاد ناهنجاریهای نظیر فرونشانی دمای گذار ابررسانایی می‌شود. در اینجا، مانشان می‌دهیم که تعمیم نظریه جایگزیدگی حفرهای بر پایه مدل‌سازی هندسی توسط نظریه پرکولاسیون می‌تواند فرونشانی دمای گذار ابررسانایی برای تمام گستره آلایدگی سیستم Pr_{CuO_2} را به خوبی توصیف کند. در این مدل مفاهیم اصلی جایگزیدگی و انبوهه سازی حفرهای ارائه و نقش بسیار اساسی آن در تزدیکی نقطه گذار فاز بررسی می‌شود به طوری که نمی‌توان از آن در هر محاسبات ویا مدل‌سازی خاص صرف‌نظر کرد. همچنین، برخی از شواهد تجربی که بر توافق بین شبیه سازی بر پایه اثرات انبوهه حفرهای و داده‌های تجربی تأکید می‌کند را فراهم آورده‌ایم.

واژه‌های کلیدی: کوپراتها پایه -Y ، خواص ترابرداری، جایگزیدگی حفرهای

۱. مقدمه

۱۲۲- R می‌شود، می‌توان فیزیک ابررساناهای دمای بالا را بهتر درک کرد. به این ترتیب آزمایشات زیادی روی ترکیبات ۱۲۲- R انجام و مقایسه کسر مولی مختلف Pr و O مورد آزمایش قرار گرفت [۱]. از طریق آزمایشها و محاسبات الکترونیکی سطح روشن شد که چگالی حفره‌ها در صفحات CuO_2 نقش حائز اهمیتی در ابررسانایی دارد و با کاهش چگالی حفره‌ها فرونشانی ابررسانایی رخ می‌دهد و آلایدگی حفره‌ای (الکترونی) در سیستم ۱۲۲- R به $\text{RBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ افزایش (کاهش) می‌دهد که افزایش چگالی صفحات CuO_2 از این صفحات افزایش T_c را به دنبال دارد [۸ و ۱۰]. به این ترتیب به نظر می‌رسد فیزیک مسئله بر پایه چگالی حفره‌ها در صفحات CuO_2 قرار داشته و چگالی حفره‌ها پارامتر اساسی در فرونشانی ابررسانایی است. اما در میان

با کشف ابررساناهای دمای بالا سری ۱۲۲، تحرک تازه‌ای در حوزه ابررسانایی رخ داد، که مبنای آن بیان توصیف قابل قبول برای این پدیده بود. از آنجا که دمای گذار ابررسانایی T_c برای ابررساناهای دمای بالا با نظریه BCS تضاد کامل داشت، به نظر می‌رسید مبنای فیزیکی دو پدیده تفاوت‌های بنیادی با هم دارد. از این جهت گروههای متفاوتی، آزمایشها زیادی را روی ترکیبات مختلف از جمله $(\text{R}-\text{R})_{\text{CuO}_2}$ به معنی عنصر لانتانید (لانتانید) انجام دادند [۹-۱]. در این میان مشخص شد که فقط Pr_{CuO_2} عایق بوده و ابررسانا نمی‌شود. بدین سبب توجه بیشتر محققین به این سری ترکیبات متوجه شد که احتمالاً با درک تفاوت بین Pr و سایر لانتانیدها و تعیین مشخصه‌ای از آن که باعث این رفتار پیچیده در ترکیبات

معرفی جزیره‌های حفره‌ای و این نکته که به وجود آمدن این جزیره‌ها در هنگام گذار و نقش آنها در کاهش ناگهانی چگالی حفره‌ها منجر به دو پله‌ای شدن گذار فاز ابررسانا- عایق می‌گردد را توضیح می‌دهیم. در این مقاله سعی داریم با بررسی سازگاری هندسه مسئله، با فرضیات فیزیکی مطرح شده، ماهیت فرونشانی ابررساناگی را بهتر درک کنیم.

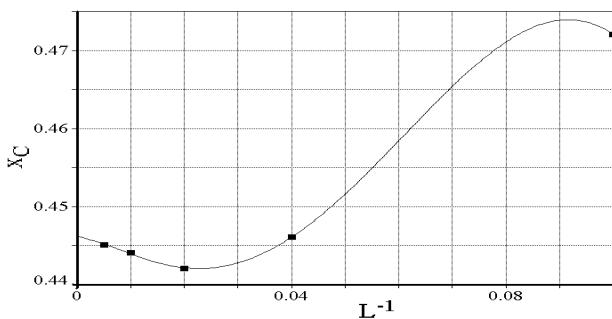
۲. جزئیات و فرضیات محاسباتی

در واقع، مسئله عایق و رسانا است، بدین ترتیب که یک شبکه از نقاط عایق و رسانا تشکیل می‌شود، که با احتمال p سامانه‌ها رسانا می‌شود. در این مسئله با افزایش p کم کم خوش‌های رسانا تشکیل می‌شود، که با افزایش p اندازه این خوش‌ها بزرگ‌تر شده تا آنجا که ابعاد آنها به ابعاد سیستم می‌رسد. در این حالت یک خوش رسانا خواهیم داشت که مرزهای سیستم را به هم متصل نموده و کل سیستم به فرم رسانا در می‌آید و این مرحله گذار فاز عایق - رسانا نامیده می‌شود، که در $p_c \approx 0.6$ رخ می‌دهد [۱۹]. در حالت واقعی سیستم اندازه بسیار بزرگی دارد و تعداد سامانه‌ها به بینهایت می‌کند. اما در عمل در محاسبات کامپیوترا برای به دست آوردن جوابهای واقعی رفتار جواب برحسب اندازه سیستم را بررسی می‌نماییم و بعد از پشت سر گذاشتن حد ترمودینامیکی، با برونویابی جواب در اندازه واقعی سیستم (اندازه بینهایت) را به دست می‌آوریم. جالب توجه است که در $p \sim p_c$ خوشة حاصل از سامانه‌های رسانا با اندازه بینهایت ظاهر می‌شوند بدین معنی که ابعاد خوشه‌های حاصل از سلوهای رسانا به سمت ابعاد سیستم می‌کند و این خوشه تمام سطح سیستم را می‌پوشاند. اما به شکل بسیار متخلخل و با تعداد عناصر سطحی محدود که سهم خوشه بینهایت نسبت به کل سامانه‌های رسانا در $p \sim p_c$ بسیار کوچک است. در نتیجه ما یک ساختار فراکتالی با بعد اندکی بیش از ۱ [۱۹] داریم که در $p \sim 1/10$ بعد آن به ۲ می‌رسد. افزایش سهم سطحی خوشه‌ها در نزدیکی نقطه گذار فاز رفتار توانی است و به ما یک نمای بحرانی می‌دهد، که به دست آوردن آن در مدل پرکولاسیونی که برای توصیف

لانتانیدها این تنها Pr است، که وجود آن در ترکیبات CuO₂-R سبب می‌شود که چگالی حفره‌ها در صفحات کاهش یابد [۸]. از طرفی آلایش Ca در ترکیب Ca-R چگالی حفره‌ها نقش بهسازای در نمود و کاهش آن در فرونشانی ابررساناگی دارد. با این جمع بندی به نظر می‌رسد، کلیه تحقیقات متوجه تفاوت بین Pr و سایر لantanیدها است. بررسی این تفاوت را می‌توان به دو گونه انجام داد: یکی محاسبات الکترونیکی سطح و محاسبه تفاوت اثر Pr و سایر لantanیدها و انجام آزمایشها برای دستیابی به نتایج مشابه و دوم بررسی فیزیک مسئله از دیدگاه هندسی و به دست آوردن هندسه سازگار با موضوع و جستجو برای یافتن فیزیکی در چهارچوب این هندسه. در خصوص تأثیر آلایش Pr در ساختار، نظریه‌های متنوعی از جمله نابجانشینی Pr [۱۱]، جایگزیدگی حفره‌ها در هیبریداسیون اوربیتال ۲p، اکسیژن و ۴f، ۱۱، ۱۲ و ۱۵، پرشدگی حفره‌ای [۱۲ و ۱۳] و شکست جفت [۱۱ و ۱۷] ارائه شده‌اند. علاوه بر این نظریه‌ها تلاشهایی در جهت استفاده از ترکیبی از این نظریه‌ها شده است. تعدادی از محققین پیشنهاد کرده بودند که اثر همزمان پرشدگی حفره‌ها و شکست جفت می‌تواند فرونشانی این گذار فاز را توجیه کند که با شکست مواجه شد [۱۸].

ما سعی داریم به کمک نظریه پرکولاسیون، ناهنجاریهای Pr را با کمک نظریه‌های مذکور و معرفی امکان تشکیل جزیره‌های حفره‌ای^۱، مسئله را توضیح دهیم. یعنی این امکان پیش می‌آید که حفره‌های متحرک در کمربندی از سلوهای عایق شامل Pr گرفتار شوند. به این ترتیب از جمع حفره‌های متحرک در سیستم حذف می‌شوند و نشان خواهیم داد که جایگزیدگی حفره‌ای و امکان تشکیل جزیره‌ای از حفره‌ها می‌تواند فرونشانی ابررساناگی و کاهش چگالی حفره‌های صفحات CuO₂ را تبیین کرده و گذار فازی را پیش‌بینی کنند. بررسیهای اولیه ما حاکمی از آن بود که تئوری پرکولاسیون دو بعدی تحت شرایط ویژه می‌تواند نتایج تجربی را به خوبی توصیف کند و از طرفی ما با

۱.Hole Nucleation



شکل ۱. مطالعه رفتار C_x با تغییر طول شبکه، نشان می‌دهد برای $L > 5.$ در حد ترمودینامیکی هستیم.

و یک حفره متحرک را جایگزین می‌کنند [۱۱، ۱۲ و ۲۳]. ۲- یک سل عاری از آلایش را به عنوان سل رسانا تلقی می‌کنیم که به طور موضعی یک سل بدون آلایش با مقدار چگالی حفره‌ای گزارش شده $25/0$ ابررسانا خواهد بود [۱۱، ۱۲ و ۲۳]. ۳- حضور Pr به جای Ba نیز سلولهای ابررسانا را به عایق تبدیل می‌کند [۲۴].

۴- تمایل R ها برای ایجاد خوشه‌های مستقل با افزایش اندازه یون R افزایش می‌یابد و برای یونهای بزرگ باید این اثر لحظه شود، اما برای Pr و Gd به دلیل کوچکیشعاع یونی آنها از این اثر صرف نظر می‌کنیم و توزیع را کاملاً یکنواخت می‌گیریم [۱۱، ۱۲ و ۲۵].

۵- در 123 Gd- با اکسیژن کامل $(x=0, \delta=0/25)$ با اکسیژن کامل است [۱۱، ۱۲ و ۲۶] از طرفی، ترکیب در مقدار $5/0$ ساختار 123 گذار فاز ساختاری ارتورمیک به تراگونال را دارد، بدین معنی که نمونه دارای فاز ساختاری تراگونال بوده و عایق است [۲۷]. لذا این اثر را می‌توان به صورت رابطه خطی $n_{mh} = 0/25 - 8/2$ فرض کرد [۱].

۶- در واقع ما سلهای صفحات CuO_2 را به دو دسته تقسیم کرده، دسته اول آنها بی که حاوی یون R و دسته دیگر حاوی یون Pr هستند که اگر در سلهای همسایه آنها یون Pr وجود نداشته باشد، گروه ابررسانایی را تشکیل خواهد داد و آنها را سامانه S مینامیم. دسته دوم سلهای حاوی Pr هستند که اگر در همسایگی آنها حداقل یک Pr وجود داشته باشد عایق می‌شوند و این دسته را سامانه N مینامیم. مجموعه‌ای از سامانه‌های S

ناهنجاریهای آلایش Pr در ساختار 123 بیان خواهد شد، رفتار سیستم را تبیین می‌کند [۱۹-۲۲]. ما نمی‌توانیم ابعاد واقعی سیستم را برای مدلسازی انتخاب کنیم و از طرفی، در مدل‌های ما نسبت سلولهای مرزی به سلولهای داخلی خیلی بزرگ‌تر از مقدار واقعی آن خواهد بود و همین موضوع جوابها را با خطا مواجه می‌کند. برای حل این اثر، مسئله را برای چند اندازه متفاوت حل کرده و سپس با برونو یابی جواب واقعی مسئله را پیدا می‌کنیم. همچنان که در شکل ۱ مشاهده می‌شود برای ابعاد شبکه بزرگ‌تر از 50×50 مدل، مشابه حد ترمودینامیکی رفتار می‌کند.

ساختار شبکه Gd/Pr-CuO_2 از دو صفحه CuO_2 تشکیل شده، که در آن Pr به طور کاتورهای جایگاه Gd را اشغال می‌کند. به این ترتیب سیستم را می‌توان به صورت صفحات دو بعدی تصور کرد، که Pr به طور کاتورهای در جایگاه Gd نشسته است (شکل ۲). البته با این فرض که توزیع Pr نسبت به صفحه CuO_2 یکنواخت باشد، لذا احتمال یافتن Pr به جای Gd در هر سل CuO_2 ، CuO_2 خواهد بود. هر مریع متشکل از چهار یون Cu و چهار یون O که با R از نظر هندسی به صورت شکل ۲ (راست) مرتبط هستند را یک سل می‌نامیم. در مدل پرکولاسیون گذار رسانا- عایق در $p_c \sim 0/6$ مشاهده می‌شود، که در آن p احتمال یافتن سل رسانا است، خوشه‌های رسانا تا ابعاد بینهایت رشد می‌کنند و مدل رسانا می‌شود [۱۹]. در اینجا $p \approx 1-x$ خواهد بود، لذا خواهیم داشت $x_c \sim 0/4$. آزمایشها نیز نشان می‌دهد که گذار ابررسانا- عایق در $p_c \sim 0/46$ رخ می‌دهد [۸].

اعمال نظریه‌های مختلف جنبه‌های تأثیرگذاری یون Pr بر پدیده ابررسانایی و فرونشانی آن، از طریق محاسبه چگالی حفره‌های موجود در صفحات CuO_2 انجام می‌پذیرد. تناظر چگالی حفره‌ای صفحات CuO_2 و دمای گذار ابررسانایی در مراجع [۱، ۸ و ۹] بحث شده است. در اینجا فرضیات مطابق با هر نظریه در الگوریتم برنامه در نظر گرفته شده است. این فرضیات عبارتند از:

۱- یونهای اکسیژن در صورتی که دو همسایگی آنها با Pr پر شده باشد، دامی برای حفره‌های متحرک محسوب می‌شوند

متوجه در صفحات CuO_2 و فرونشانی دمای گذار ابرسانایی با هم مرتبط هستند [۱، ۷-۹]. لذا به نظر می‌رسد بخش عمدتی از مسئله پیدا کردن علت این تابعیت و فرماییزه کردن آن باشد. اما نکته در اینجاست که فیزیک این مسئله کماکان به درستی مورد تأیید نیست و تردیدهای زیادی وجود دارد و هر آزمایش نتایج خاص خود را به دنبال دارد و در عین حال هیچ الزامی وجود ندارد که این پدیده تنها یک عامل داشته باشد و این بر پیچیدگی موضوع نیز می‌افزاید. راه حل غالب آن است که با مطرح کردن یک فرض، مدلی ارائه و حل شود و یا با استفاده از مدل‌های از پیش تعریف شده در بخش‌های دیگر فیزیک، تخمینهایی اعمال کرده و صحت فرض اولیه بررسی شود. راه حلی که ما ارائه کرده‌ایم، نگاه کردن به هندسه مسئله و به دست آوردن نتایج با فرضهای اندک و تنها برپایه هندسه است. به این ترتیب می‌توان فرضیات فیزیکی را صرفاً با این دیدگاه که با هندسه سازگاری دارند و یا خیر، مهم و یا بی اهمیت تلقی کرد. البته مزیت دیگر در اینجاست که پاره‌ای از خصوصیات مهم، صرفاً بر پایه فرضیات هندسی قابل توجیه بوده و نیازی به صرف وقت برای توجیه آنها برپایه جزئیات فیزیکی نخواهد داشت. در این مسئله می‌توان کلیه بررسیها را روی یکی از لانتانیدها مثلاً Gd و Pr متمرکز کرد چرا که برای سایر لانتانیدها T_c با کاهش اندازه یون افزایش می‌یابد [۳۱]. در $\text{Gd}-\text{Nd}$ آلاییده با Pr گذار فلز به عایق (MIT)^۳ در مقدار بحرانی آلایش مشاهده شده است و این گذار کماکان در تمامی ساختارهای CuO_2 مساهده شده است که با Pr آلاییده شوند، در مقادیر x خاصی از جمله 0.32 برای $\text{Nd}-\text{CuO}_2$ و 0.60 برای $\text{Y}-\text{CuO}_2$ مشاهده می‌شود [۸]. از طرفی دیگر اثر کمبود اکسیژن^۴ نیز فرونشانی ابرسانایی را به همراه دارد [۱]. اگرچه کاهش اکسیژن در زنجیره‌های ساختار رخ می‌دهد، اما انتقال بار به سمت صفحات CuO_2 بر چگالی بار حفره‌ها در این صفحات تأثیر می‌گذارد و در نتیجه دمای گذار ابرسانایی که با چگالی حفره‌ها در صفحات CuO_2 در ارتباط است فرونشانده می‌شود [۱ و ۱۱].

متصل به هم، خوش S و مجموعه‌ای از سامانه‌های N متصل به هم خوش N را تولید می‌کنند (شکل ۲).

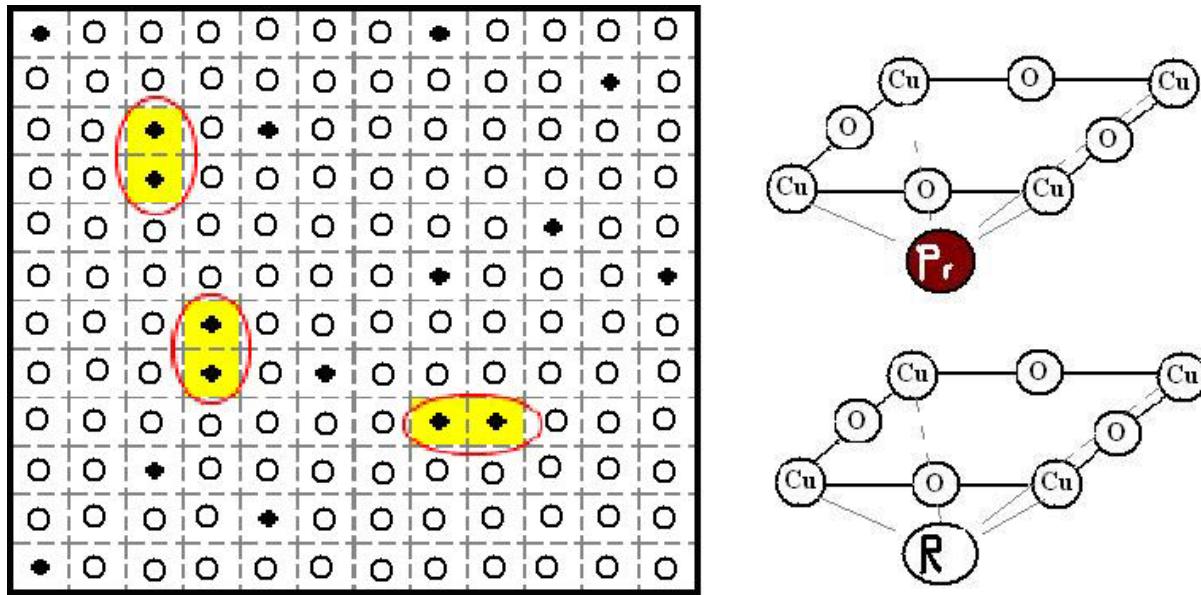
- ۷- از اثر تونل زنی جوزفسون، که باعث می‌شود خوش‌هایی که به وسیله کمریند سلهای عاری از حفره از هم جدا شده‌اند و به طور ضعیف به هم مرتبط می‌شوند صرف نظر می‌کنیم [۲۸].
- ۸- هر دو Pr که روی دو سل مجاور قرار گیرند، می‌توانند حفره متوجه را به دام اندازند. اما از نظر فیزیکی خلاف انتظار ماست که در یک سل چهار حفره به دام بیفتد، زیرا که در عمل عوامل دیگری از جمله اثر دافعه کولنی بین حفره‌ها غلبه می‌کند و این احتمال را کاهش می‌دهد [۱۱].

۳. بحث و بررسی نتایج

در اینجا ما صرفاً توجه خود را به طیفی از ابرساناهای دمای بالا معطوف می‌کنیم که در رده ترکیبات $\text{R}-\text{CuO}_2$ قرار می‌گیرند و T_c در $\text{Y}-\text{CuO}_2$ ، $\text{Gd}-\text{CuO}_2$ و $\text{Nd}-\text{CuO}_2$ در محدوده $92\text{--}94\text{ K}$ گزارش شده است [۸ و ۲۹]. نکته جالب توجه این است که در این بین تنها Pr است که ساختار ارتورومیک CuO_2 را ایجاد می‌کند ولی ابرسانا نیست [۸]. البته با کاهش اکسیژن در این ترکیبات گذار فاز ساختاری Orthorhombic - Tetragonal (O-T) نیز رؤیت می‌شود [۱]، که بین همه ترکیبات CuO_2-R مشترک است. این نکته بسیار جالب است چرا که تفاوتی در یک خانواده از عناصر جدول تناوبی ظاهر شده و در عین حال این تفاوت نمی‌تواند از ساختار شبکه و یا اندازه اتمها ناشی شده باشد چون از این جهت تفاوتی بین Pr و سایر لانتانیدها دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که اگر به درستی این تفاوت درک شود، بتوانیم گامی در تبیین علت ابرسانا بودن سایر CuO_2-R ها برداریم. به این جهت آزمایشات زیادی از طرف گروههای متعددی از محققین بر روی ترکیبات مختلف این عناصر به همراه کسر مولی متفاوتی از Pr انجام شد، تا تفاوت بین آنها و Pr روشنتر گردد [۸]. موازی با این آزمایشها، محاسبات نیز نشان داد بین تغییر فاز و چگالی حاملها در صفحات CuO_2 ارتباط نزدیکی وجود دارد [۱]. آزمایشها نشان دادند کاهش n_{mh} چگالی حفره‌های

۱. Metal Insulator Transition

۲. Oxygen Deficiency



شکل ۲. راست) وضعیت یونهای Pr و R نسبت به صفحه CuO_2 . چپ) سلهای رنگی نقطه‌ی را نشان می‌دهند که در آنها حفره‌ها جایگزینی شده‌اند.

در نتیجه برای مطابقت با نتایج تجربی می‌بایست برابری $n_{Exp} \sim n_{mh} f_S$ را بررسی کنیم.

با فرض پخش کاتورهای اتمهای Pr در سطح صفحات CuO_2 ، احتمال داشتن همسایه برای یک سل CuO_2 شامل Pr، $4x^2$ خواهد شد، با توجه به اینکه حفره جایگزینی به دو سامانه همسایه تعلق دارد، برای چگالی حاملها مقدار n_{mh} به صورت زیر پیش‌بینی می‌شود.

$$n_{mh} = 0.25 - 2x^2. \quad (3)$$

از طرفی می‌توان سهم سطح کلی خوش‌هایی را، که به این ترتیب عایق نشده‌اند، یعنی f_S ، را حساب کرد.

$$f_S = (1-x) + x(1-x)^3. \quad (4)$$

به این ترتیب احتمال وجود سامانه‌ای ابررسانا f_S خواهد بود. حال به کمک مدل ساده پرکولاسیون رسانا-عایق که گذار فاز $p_c \sim 0.06$ را پیش‌بینی می‌کند نتیجه می‌گیریم، که برای $f_S \sim 0.045 \leftarrow f_S \sim 0.04$ ، که با نتایج آزمایشگاهی نیز همخوانی دارد.

اثر جایگزینی حفره‌ها با افزایش میزان آلایش Pr افزایش می‌یابد و به دلیل افزایش دافعه کولنی در $n_{mh} \approx 0.15$ تأثیر خود را از دست می‌دهد [۱۱]. اما با دقت بیشتر ملاحظه می‌شود

لذا کمبود اکسیژن در سیستم ۱۲۳ نیز با کاهش چگالی حفره‌ها در صفحات CuO_2 همراه خواهد بود. اثر همزمان کمبود اکسیژن و آلایش Pr در سیستم $\text{Gd}-123$ در کار قبلی ما به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است و همبستگی x و δ در فرونشانی ابررسانایی به دست آمده است [۱].

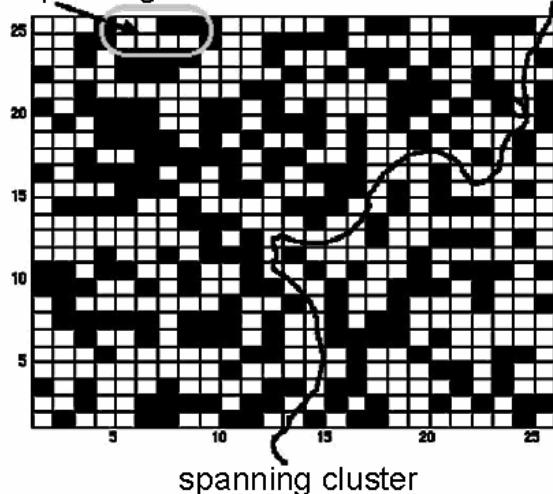
چگالی حفره‌ها در سطح CuO_2 ، تعداد حفره‌های متحرک تقسیم بر سطحی که در آن قابلیت تحرک دارند تعریف می‌شود یعنی (n_{mh}/f_S) که چگالی حفره‌های متحرک و f_S نسبت سطح سلهای ابررسانا به سطح کل صفحه CuO_2 است. ولی در عمل n_{Exp} با استفاده از اثر هال اندازه‌گیری می‌شود (شکل ۴)، لذا از دانش اولیه اثر هال داریم:

$$n_{Exp} = \frac{Bi_{Exp}}{etV}, \quad (1)$$

که در آن t ضخامت تیغه، B میدان مغناطیسی، e بار حامل و V ولتاژ هال و i_{Exp} جریان اعمال شده می‌باشد. با توجه به اینکه رابطه (۱) برای رسانا یکنواخت به دست آمده است، برای تیغه‌ای که سهم سطح رسانا به کل سطح آن f_S باشد خواهیم داشت.

$$n_{mh} = \frac{Bi_{Exp}}{etVf_S} = n_{Exp}/f_S. \quad (2)$$

non spanning cluster



spanning cluster

شکل ۳. انواع خوشها : سلهای مشکی معرف سلوهای آلاییده با Pr (سل N) و سلهای سفید معرف سلوهای غیر آلاییده (سل S) هستند.

ساخت در مرحله کلوخه سازی است. در مجموع رابطه احتمال را بعد از بهنجارش به فرم زیر می نویسیم.

$$P_{Pr-R} = \frac{e^{-\Delta E / KT}}{1 + e^{-\Delta E / KT}} . \quad (6)$$

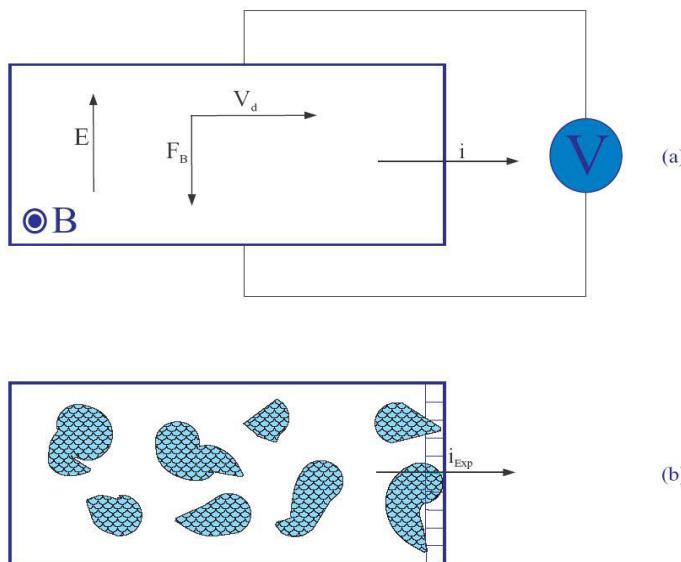
در نتیجه احتمال کنار Pr قرار گرفتن عناصر مختلف لانتانیدها به کمک رابطه ۶ محاسبه می شود.

در مقدار آلاییشهای بیشتر کم کم خوشها N بزرگتر می شوند. این خوشها دو دسته هستند، خوشها کوچکتر که عموماً توپر هستند و کلیه حفره های داخل آنها جایگزیده خواهند بود و دسته دوم خوشها بایی توانی، که بیشتر کمرنندی از سلهای N هستند، که مجموعه ای از سلهای S حاوی حفره های متحرک را دربر می گیرند (شکل ۳). به وضوح مشاهده می شود حفره های داخل این چنین کمرندهایی قابلیتهای رسانشی خود را عملاً از دست داده و حفره جایگزیده به حساب می آیند (non spanning cluster). ما این اثر را جزیره حفره ای می نامیم. همچنان که x به x نزدیک می شود تعداد خوشها از نوع دوم به شدت افزایش یافته و کاهش سریع چگالی حفره های متحرک را به دنبال دارد و کلیه حفره های متحرک، در کمرنندی از سلهای N که کل سیستم را دربر می گیرد احاطه می شوند (شکل ۳). این

که با افزایش x چگالی حفره های غیر متحرک در ناحیه عایق کم کم افزایش می یابد، در عمل حفره ها اجازه حرکت و ایجاد جریان را دارند، اما به طور جمعی نمی توانند به بخشی از شبکه مهاجرت نموده و عدم توازن بار را به وجود آورند، چرا که این مخالف اثر پتانسیل کولنی است ولی در x های کوچک چنین اثری ظاهر نمی شود. اما در x های بزرگتر، $n_{mh} < 0.15$ ، در مدل اجباراً کاهش بسیار شدید توزیع چگالی حفره ها را در مناطق غیر عایق به وجود می آورد. این عدم تقارن در توزیع بار برای وقتی شعاع R و Pr تفاوت زیادی دارند، در x های کوچکتر نیز ظاهر می شود و به این ترتیب اثر بیشتری خواهد داشت و در نتیجه انتظار داریم برای آنها اندکی بزرگتر از 0.15 نیز باشد. به همین دلیل فرض جایگزیدگی تنها در x های کوچک توضیح مناسی را ارائه می دهد. براین اساس ما فرض جایگزیدگی را تنها تا $n_{mh} \geq 0.15$ اعمال می کنیم. حذف ناگهانی فرض جایگزیدگی، اگرچه یک تخمين است اما جواب مناسبی به دنبال خواهد داشت. چرا که در عمل تشکیل جزیره های حفره ای پدیده جایگزیدگی را شامل خواهد بود و چگالی حفره های متحرک را به سرعت کاهش می یابد. بستگی مدل به نوع اتمهای R نیز از این دیدگاه تجربی ناشی می شود که هرچه اختلاف اندازه اتم R و Pr بیشتر باشد، سرعت افت اولیه چگالی حفره ها بر حسب x بیشتر خواهد بود. از طرفی آزمایشها نشان داده است که هر چه اختلاف اندازه اتمهای R و Pr بزرگتر باشد تمایل این اتمها برای تشکیل خوشها یکپارچه بیشتر می شود و فاز مجزاتری از هم را اختیار می کنند [۳۱]. در نتیجه در مدل پرکولاسیون تنها برای اتمهایی مثل Y می توانیم توزیع را برای Pr کاملاً اتفاقی انتخاب کنیم. برای وارد کردن این اثر، انتخاب R و یا Pr برای یک سامانه از سلو، که روی انرژی سیستم مؤثر است، می توان مقدار این تأثیر را به طور تخمینی از انرژی یونیزاسیون E_{ion} و مدول یانگ اتم (y) به دست آورد.

$$E = E_{ion} - y . \quad (5)$$

حال احتمال قرار گرفتن دو اتم ناهمجننس در کنار هم متناسب با $e^{-(E_{Pr}-E_R)/KT}$ خواهد بود که T در این رابطه دمای

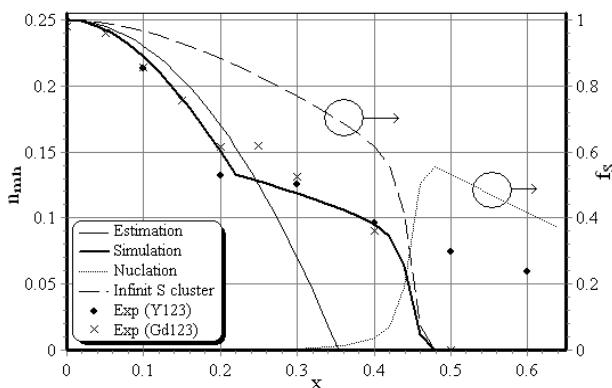


شکل ۴. الف) نمایش اثر هال. ب) تیغه‌ای با خوشه‌های نارسانا که باعث می‌شود جریان نسبت به حالت رسانای یکنواخت کاهش پیدا کند. در صورتی که سهم رسانا به کل سطح f_S باشد، خواهیم داشت $i_{\text{exp}} = i \times f_S$.

پرشدگی حفره‌ای نمی‌توانند دو پله‌ای شدن و گذار فاز ابررسانا- عایق را توجیه کند [۲۴] ولی هر مقدار که از این اثرات در فرونشانی مؤثر باشند می‌توانند مشابه اثر جایگزیدگی حفره‌ها، کمربندی از عایق را در صفحات CuO_7 به وجود آورند و حفره‌های بیشتری را در مقادیر بالاتر آلایش از سیستم خارج کنند. علاوه بر این، فرضهای پرشدگی، شکست جفت و نابجاشینی Pr از نظر هندسی وابسته به یک یون بوده و در ایجاد خوشه‌های N ، ضعیفتر از فرض جایگزیدگی عمل می‌کنند، هر چند که اثر جزیره حفره‌ای صرفاً وابسته به فرض جایگزیدگی حفره‌ای نیست. توجه به این نکته که در این مرحله کم کم خوشه‌های ابررسانا با کمربندی از سلهای N از هم جدا شوند و عملاً نقش خود را در رسانش از دست می‌دهند، تقریب ثابت فرض کردن چگالی حاملها تقریب مناسبی خواهد بود. در واقع با افزایش x به یک نقطه بحرانی می‌رسیم که دیگر خوشه‌ای با ابعاد سیستم وجود ندارد، یعنی در این لحظه گذار به فاز عایق اتفاق می‌افتد. شکل ۵ اثر جایگزیدگی حفره‌ای را نشان می‌دهد که در آلاییدگی کم به خوبی داده‌های تجربی را تبیین می‌کند ولی در مقادیر زیاد جوابگو نیست. شکل ۶ اثر جایگزیدگی حفره و جزیره حفره‌ای را نشان می‌دهد و مشاهده

نقشه همان نقطه‌ای است که گذار ابررسانا- عایق مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد که بتواند تیزی افت T_c را در نزدیکی n_{mh} و رسیدن آن به یک حد n . که در ترکیبات مختلف $R - R$ متفاوت است گذار فاز رخ می‌دهد، به طور تجربی نیز در ترکیبات مختلف هم این گذار فاز در نقاط مختلف رخ می‌دهد [۲۴].

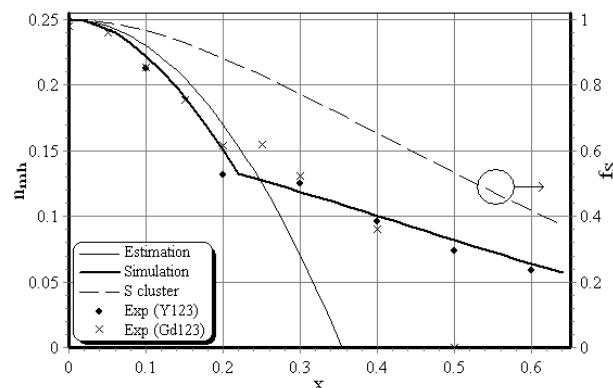
در شکل‌های ۵ و ۶ نتایج به دست آمده بر اساس تئوری پرکولاسیون به کمک محاسبات عددی نمایش داده شده است. نکته قابل توجه اینجاست، که با افزایش x چگالی حفره‌های متحرک کاهش پیدا می‌کند. اما در مقابل اثر دافعه کولنی نیز کم افزایش می‌یابد تا آنجا که مانع جایگزیدگی بیشتر حفره‌ها می‌شود. از این مرحله به بعد ما صرفاً اثر ضریب f_S را در نظر می‌گیریم و چگالی حفره‌ای را با توجه به اثر دافعه کولنی ثابت فرض می‌کنیم. زیرا به دلایل زیر اثر جزیره حفره‌ای حاکم بر رفتار سیستم خواهد بود: اولاً احتمال تحقق نابجاشینی Pr از ۱٪ است [۲۵ و ۳۲]، ثانیاً اثر پرشدگی حفره‌ای باعث کاهش چگالی حفره‌ها می‌گردد اما نمی‌تواند نتایج تجربی را توصیف کند [۱، ۱۱ و ۳۳] و ثالثاً شکست جفت و حتی همزمان با



شکل ۶. نمودار چگالی حاملها در صفحه CuO_2 با لحاظ کردن اثر جزیره حفره. خط نازک نمایش رابطه ساده تخمینی $n_{mh} = 0.25 - 2x^3$ است. خط ضخیم نتیجه شبیه‌سازی کامپیوتری برای Gd-123 و خط چین سهم خوش‌های S به کل سطح است. نقاط توپر نتیجه تجربی برای Y-123 [۱۷ و ۱۹] و ضربدر نتیجه تجربی برای Gd-123 [۲۴] است. نقطه چین سهم جزیره‌های حفره از کل سطح است.

خوش‌هایی که ابعاد کوچکتر از ابعاد سیستم دارند سهم کل حفره‌ها را کاهش می‌دهند منحنیهای نقطه چین در شکل‌های ۵ و ۶ سهم این خوش‌ها را از کل سطح نشان می‌دهد.

به طور خلاصه، رفتار T_c بر حسب آلایش Pr در سیستم Gd-123/Pr- x با استناد به آزمایشها مکرری که انجام گرفته است خطی نبوده و دارای دو پله (Plato) است. پله اول: در آلایش کم (x های کم و یا $1/15$) اثر جایگزیدگی حفره‌ها غالب است زیرا که تراکم سلهای N نسبت به سلهای S بسیار کم است. با افزایش x اثر دافعه کولنی حفره‌ها جایگزیده افزایش می‌یابد و به حدی می‌رسد که از اثر جایگزیدگی حفره‌ها در اثر جانشینی بیشتر Pr/R جلوگیری می‌کند. پله دوم: از این مرحله به بعد یعنی در آلایشهای زیاد (x های بالا و یا $1/15 \leq n_{mh} \leq 0.15$) اثرات تجمعی حفره‌ها ظاهر می‌شود و جزیره‌های حفره‌ای شکل می‌گیرد. این جزیره می‌تواند تماماً از سلهای N تشکیل شده باشد و یا اینکه مجموعه‌ای از سلهای S درون کمرنندی از سلهای N بدام افتاده باشند که باعث حذف آنها از خوش‌های S می‌گردد. با نزدیک شدن به x رفتار شدید شده و گذار فاز ابررسانا - عایق رخ می‌دهد. در تمامی مراحل بالا اثرات پرشدگی حفره‌ها،



شکل ۵. نمودار چگالی حاملها در صفحه CuO_2 . خط نازک نمایش رابطه ساده تخمینی $n_{mh} = 0.25 - 2x^3$ است. خط ضخیم نتیجه شبیه‌سازی کامپیوتری برای Y-123 و خط چین سهم خوش‌های S را به کل سطح است. نقاط توپر نتیجه تجربی برای Y-123 [۱۷ و ۱۹] و ضربدر نتیجه تجربی برای Gd-123 [۲۴] است [۴].

می‌شود در تمام محدوده تغییرات آلایش رفتار نمونه Gd-Pr-123 را تبیین می‌کند.

آنچه مشخصاً در مورد همه R ها [۲۴] دیده می‌شود این است که در چگالی حفره $n_{mh} \sim 0.15$ جایگزیدگی حفره‌ها متوقف می‌شود. این نقطه در ترکیبات مختلف بر حسب مقدار Pr متفاوت خواهد بود، اما در عین حال با نقطه‌ای که تغییر ساختار O-T در آن گزارش شده متناظر است [۳۱]. از طرفی با توجه به این وابستگی چگالی حاملها مشابها می‌توان با تکیه بر تغییر مقدار اکسیژن δ در $\text{RBa}_x\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ اثر مشابه تغییر ساختار را دید، که در کار قبلی به تفصیل روی آن بحث شده است [۱].

از دیدگاه پرکولاسیون نیز می‌توان این مسئله را بازبینی کرد، با افزایش x مشاهده می‌شود، که بعد خوش‌های S از ۲ به سمت ۱ میل می‌کند. از آنجا که وابستگی انژری پتانسیل کولنی در ابعاد پایین به تغییر چگالی شدیدتر است، لذا اثر دافعه کولنی با افزایش Pr افزایش می‌یابد، تا جایی که مانع جایگزیدگی حفره‌ها می‌شود. اما همان طور که گفته شد، در مقابل با کاهش بعد خوش‌های S در واقع از هم گسیخته می‌شوند و ارتباط مستقیم رسانشی با هم را از دست می‌دهند، از آنجایی که

قدردانی

نویسنده‌گان مقاله کمال تشکر را از دکتر اخوان به خاطر راهنماییها و همفکریهای سودمند ایشان دارند. همچنین از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) به خاطر حمایت مالی تشکر می‌کنند.

نایابجاشنی وغیره با توجه به اینکه نقش اساسی را ایفا نمی‌کنند اما در شدت بخشنیدن به رفتار تجمعی حفره‌ها و ایجاد جزیره حفره‌ای خصوصاً در نزدیکی x_c دخالت دارند. شکل ۶ به خوبی دوپله‌ای بودن گذار فاز ابررسانا - عایق در سیستم ۱۲۳ آلایده با Pr را نشان می‌دهد.

مراجع

17. A Kebede, C S Jee, J Schwelger, J E Crow, T Mihalision, G H Myer, R E Salomon, P Schloemann, M V Kuric, S H Bloom and R P Guertin, *Phys. Rev. B* **40** (1989) 4453.
18. J J Neumeier, T Bernholm, M B Maple and I K Schuller, *Phys. Rev. Lett.* **63** (1989) 2516.
19. D Stauffer and A Aharony, "Introduction to Percolation Theory", Taylor & Francis, Washington, DC, (1992).
20. J W Greene, A El Gamal, *J. Assoc. Comput. Mach.* **31** (1984) 694.
21. J Hoshen and Kopelman, *Phys. Rev. B*, **14** (1976) 3438.
22. J Hoshen, *Pattern Recognition Lett.* **19** (1998) 575.
23. M Muroi and R Street, *Physica C* **228** (1994) 216.
24. H A Blackstead, J D Dow, D B Chisey, J S Horwitz, M A Black, P J McGinn, A E Klunzinger, and D B Pulling, *Phys. Rev. B*, **54** (1996) 6122.
25. C H Booth, F Bridges, J B Byce, T Claeson, Z X Zhao and P Cervantes, *Phys. Rev. B*, **49** (1994) 3432.
26. K Takenaka, Y Imanaka, K Tamasaku, T Ito and S Uchida, *Phys. Rev. B*, **46** (1992) 5833.
27. J D Jorgensen et al., *Phys. Rev. B* **41** (1990) 1863.
28. H B Radosky, *J Mater. Res.* **7** (1992) 1917.
29. M K Wu, J R Ashburn, C J Torng, P H Hor, L Meng, L Gao, Z J Huang, Y Q Wang and C W Chu, *Phys. Rev. Lett.* **58** (1997) 908.
30. K M Pansuria, D G Kuberkar, G J Baldha and RG Kulkarni, *Supercond. Sci. Technol.* **12** (1999) 579.
31. X J Yunhui, *GCPD e.V. 5 sep.* 1999.
32. V G Harris, D J Fatemi, V M Browning, M S Ososky and T A Vanderah, *J. Appl. Phys.* **83** (1998) 6783.
1. H Khosroabadi, V Daadmehr and M Akhavan, *Modern Phys. Lett. B* **25** (2002) 943.
2. V Daadmehr and M Akhavan, *Phys. Stat. Sol. (a)* **193** (2002) 153.
3. Z Yamani and M Akhavan, *Supercond. Sci. Technol.* **10** (1997) 427.
4. M R Mohammadizadeh and M Akhavan, *Supercond. Sci. Technol.* **16** (2003) 1216.
5. M R Mohammadizadeh and M Akhavan, *Eur. Phys. J. B* **33** (2003) 381.
6. V Daadmehr, E Ziae and M Akhavan, *Physica B* **321** (2002) 313-316.
7. H Khosroabadi, M R Mohammadizadeh and M Akhavan, *Physics C* **370** (2002) 85.
8. M Akhavan, *Physica B* **321** (2002) 265.
9. Y Tokura, J B Torrance, T C Huang and A I Nazzai, *Phys. Rev. B* **38** (1988) 7156.
10. H Shakeripour and M Akavan, *Supercond. Sci. Technol.* **14** (2001) 213.
11. M Muroi and R Street, *Physica C* **301** (1998) 277.
12. M Muroi and R Street, *Physica C* **216** (1993) 345.
13. A Matsuda, K Kinoshita, T Ishii, H Shibata, T Watanabe and T Yamada, *Phys. Rev. B*, **38** (1988) 2910.
14. A P Goncalves, I C Santos, E B Lopes, R T Henruques and A Almeida, *Phys. Rev. B*, **37** (1998) 7476.
15. X X Tang, A Manthiram and J B Goodenough, *Physica C* **161** (1989) 574.
16. Fehrenbacher and T M Rice, *Phys. Rev. Lett.* **79** (1993) 2471.